Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 8500–10500 MHz



LCI-PA-8500-10500-PS52T — бескорпусной кристалл усилителя мощности GaN MMIC для диапазона 8500–10500 MHz.
Поддерживается импульсный режим.

Параметры таблицы RF: Выходная мощность насыщения: 52 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности: 24 dB (типовое); КПД с учётом добавленной мощности: 45 % (типовое). Условия измерения RF: TA = +25 °C; Vd = +48 V; Vg = -2.6 V. Размеры кристалла: 3.9 × 6.5 × 0.1 mm.

RF-параметры

TA = +25 °C; Vd = +48 V; Vg = -2.6 V

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Рабочая частота	f	8500	-	10500	MHz
Выходная мощность насыщения	Psat	-	52	-	dBm
Коэффициент усиления по мощности	Gp	-	24	-	dB
Неравномерность усиления по мощности	ΔGp	-	-	±0.5	dB
КПД с учётом добавленной мощности	PAE	-	45	-	%
Коэффициент усиления малого сигнала	S21	-	34	-	dB
Неравномерность усиления малого сигнала	ΔS21	-	-	±1	dB
Входной КСВН	VSWR(in)	-	1.6	2	-

Смещение DC и токи

TA = +25 °C

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Напряжение стока	Vd	-	48	50	V
Напряжение затвора	Vg	-3	-2.6	-2.4	V
Ток покоя стока	Id	-	3.3	-	A
Динамический ток стока	Idd	-	7	7.5	A
Динамический ток затвора	Igg	-	3	10	mA

Предельные значения

Предельные значения; не являются нормальными рабочими уставками.

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Максимальное напряжение сток–исток	Vd	-	-	50	V
Минимальное смещение затвора	Vg	-5	-	-	V
Максимальная температура канала	Top	-	-	225	°C
Температура хранения	TSTG	-65	-	150	°C

Размеры кристалла

Параметр	Значение	Единица
Размеры кристалла	3.9 × 6.5 × 0.1	mm
Допуск контура в плане	±100 (Только контур в плане; допуск толщины не указан.)	µm

Текущая публикация · 1.8 · 2026-11-12. Обновлены описание изделия или редакционные материалы. Заменяет редакцию 1.7.

Монтаж кристалла и последовательность смещения

При включении сначала подают смещение затвора, затем стока. При выключении сначала снимают смещение стока. Требуются чистая рабочая среда, защита от ESD и держатель с тепловым расширением, совместимым с кристаллом SiC.

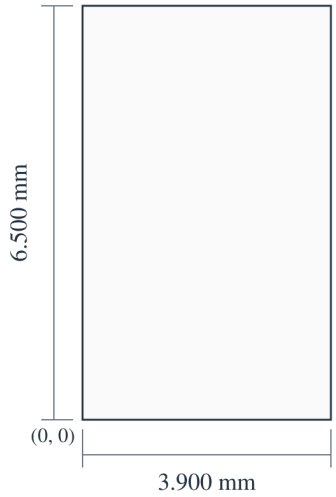
Размеры контактных площадок

Обозначение: RFin; Размеры (µm): 100 × 100. Обозначение: Vg; Размеры (µm): 120 × 100. Обозначение: Vd1; Размеры (µm): 120 × 100. Обозначение: Vd2; Размеры (µm): 120 × 100. Обозначение: Vd3; Размеры (µm): 250 × 100. Обозначение: RFout; Размеры (µm): 100 × 120.

Габаритный чертеж

Контур и координаты с нанесёнными размерами в mm. Чертёж предназначен для справки по размерам. Для изготовления и проволочной разварки нужны полные чертежи.

LCI-PA-8500-10500-PS52T



X (mm)
Vg: 0.300
Vd1: 0.590
Vd2: 1.060
Vd3: 3.300

Y (mm)
RFin / RFout: 3.250

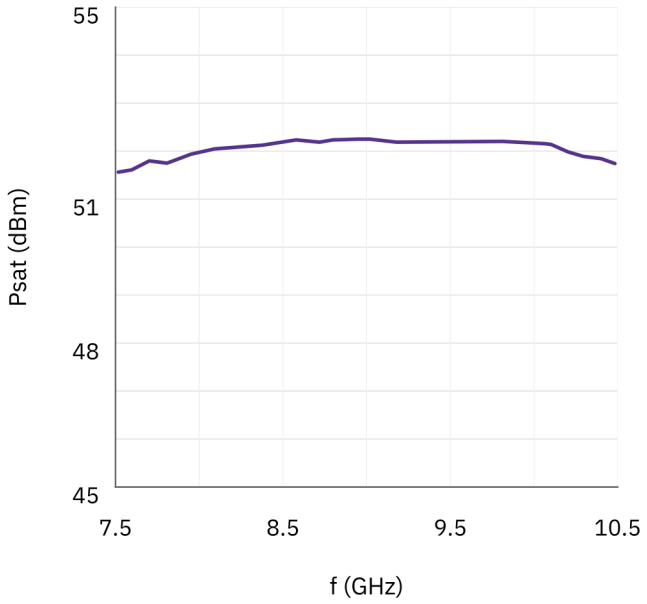
3.900 × 6.500 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

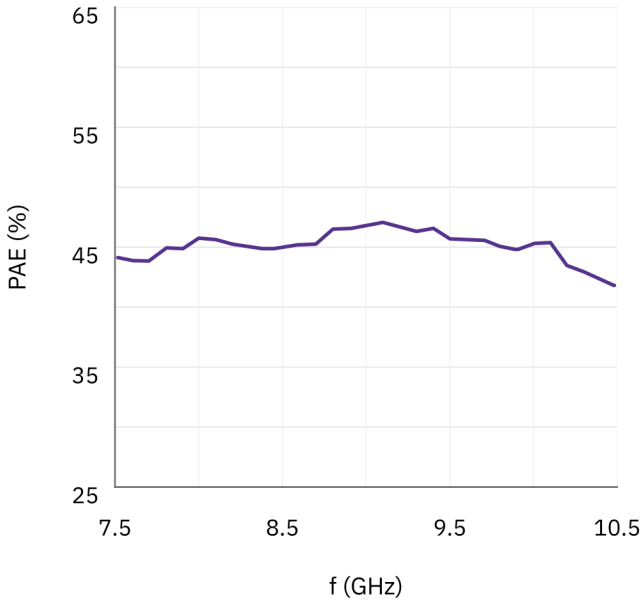
Характеристики

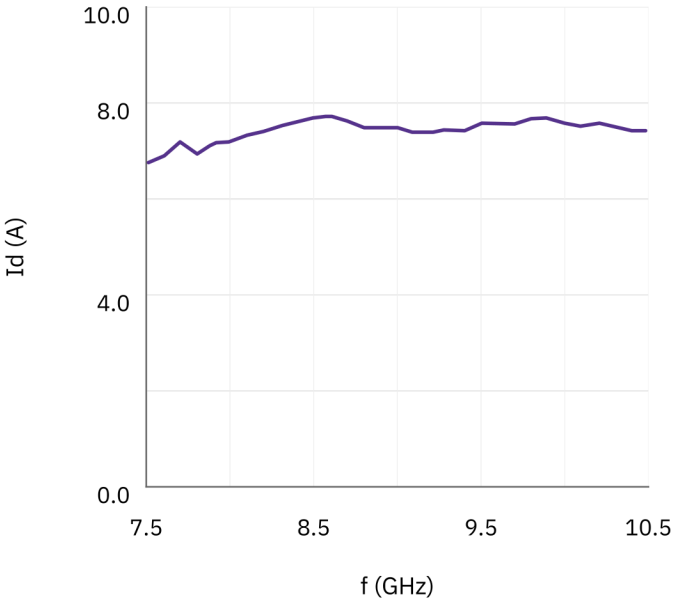
Каждый график показывает характеристики при указанных на нём рабочих условиях.

Выходная мощность насыщения; КПД с учётом добавленной мощности; Динамический ток стока.

Примечания к графику: TA=25°C; Vd=+48V; Vg=-2.6V; Pin=28dBm. Считываемые значения приблизительны.







Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.